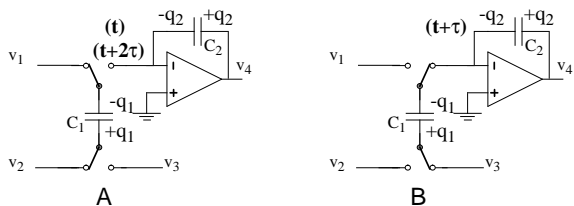


1. a) Laddningsanalys



1. Switch enl. A: (t)

$$q_1(t) = C_1(v_2(t) - v_1(t)) ; q_2(t) = C_2v_4(t) \quad (\text{Eq. 1})$$

2. Switch enl. B: (t+τ)

$$q_1(t + \tau) = C_1v_3(t + \tau) ; q_2(t + \tau) = C_2v_4(t + \tau) \quad (\text{Eq. 2})$$

Laddningen bevaras:

$$q_1(t + \tau) + q_2(t + \tau) = q_2(t) + q_1(t) \quad (\text{Eq. 3})$$

Detta ger:

$$C_1v_3(t + \tau) + C_2v_4(t + \tau) = C_1(v_2(t) - v_1(t)) + C_2v_4(t) \quad (\text{Eq. 4})$$

3. Switch enl. A: (t+2τ)

$$q_1(t + 2\tau) = C_1(v_2(t + 2\tau) - v_1(t + 2\tau)) ; q_2(t + 2\tau) = C_2v_4(t + 2\tau) \quad (\text{Eq. 5})$$

Laddningen på C₂ bevaras:

$$q_2(t + 2\tau) = q_2(t + \tau) \Rightarrow v_4(t + 2\tau) = v_4(t + \tau) \quad (\text{Eq. 6})$$

Vi får då:

$$v_4(t + 2\tau) = v_4(t + \tau) = \left| \text{Eq. 4} \right| \\ = \left(-\frac{C_1}{C_2} \cdot v_3(t + \tau) + \frac{C_1}{C_2}(v_2(t) - v_1(t)) + v_4(t) \right) \quad (\text{Eq. 7})$$

Enl. uppgift gäller v₃(t + τ) = v₃(t), dvs

$$v_4(t + 2\tau) = \frac{C_1}{C_2} \cdot v_3(t + 2\tau) + \frac{C_1}{C_2}(v_2(t) - v_1(t)) + v_4(t) \quad (\text{Eq. 8})$$

Sätt: t + 2τ = kT ; 2τ = T vilket ger:

$$v_4(kT) = -\frac{C_1}{C_2} \cdot v_3(kT) + \frac{C_1}{C_2} \cdot (v_2(kT - T) - v_1(kT - T)) + v_4(kT - T) \quad (\text{Eq. 9})$$

Z-transformera:

$$V_4(z) = -\frac{C_1}{C_2} \cdot V_3(z) + \frac{C_1}{C_2} \cdot (V_2(z) \cdot z^{-1} - V_1(z) \cdot z^{-1}) + V_4(z) \cdot z^{-1} \quad (\text{Eq. 10})$$

Detta ger:

$$V_4(z) = -\frac{C_1}{C_2} \cdot \frac{1}{1 - z^{-1}} \cdot V_3(z) + \frac{C_1}{C_2} \cdot V_2(z) \cdot \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1}} - \frac{C_1}{C_2} \cdot V_1(z) \cdot \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1}} \quad (\text{Eq. 11})$$

b) Integratorn är inte parasitkänslig ty switchen på OP:ns ingång switchas mellan v₁ och virtuell jord. Detta medför att en eventuell parasitkapacitans laddas upp till v₁ i ena switchläget för att sedan laddas ur i det andra. Denna extra laddning ger en felaktig utsignal.

2. För LDI-transformen gäller $s = s_0 \frac{z-1}{z^{1/2}}$ och $\omega_a = 2s_0 \sin\left(\frac{\omega T}{2}\right)$. Transformera filterkaven på den anloga insignalen (ω) till ett filterkrav för det anloga referensfiltret (ω_a).

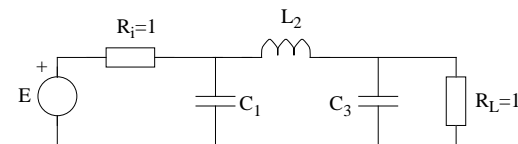
$$\text{Välj } \omega_{ac} = 1 \Rightarrow s_0 = \frac{\omega_{ac}}{2 \sin\left(\frac{\omega_c T}{2}\right)} = \frac{1}{2 \sin\left(\frac{2\pi \cdot 1k}{2 \cdot 40k}\right)} = 6.37 \text{ rad/s}$$

$$\text{Detta ger } \omega_{as} = 2s_0 \sin\left(\frac{\omega_{as} T}{2}\right) = 2 \cdot 6.37 \cdot \sin\left(\frac{2\pi \cdot 4k}{2 \cdot 40k}\right) = 3.94$$

För referensfiltret gäller således $A_{MAX} = 3\text{dB}$, $A_{MIN} = 30\text{dB}$ och $\frac{\omega_{as}}{\omega_{ac}} = 3.94$

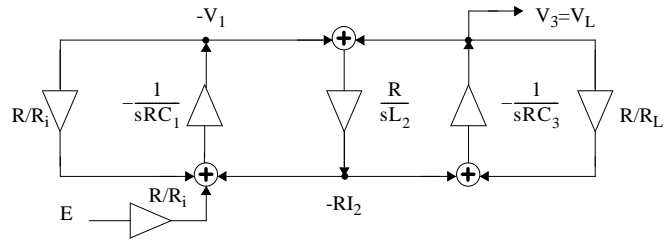
$$\text{Filtrets gradtal: } N = \text{INT} \left(\frac{1}{2} \frac{\lg\left(\frac{10^{0.1A_{MIN}} - 1}{10^{0.1A_{MAX}} - 1}\right)}{\lg\left(\frac{\omega_{as}}{\omega_{ac}}\right)} \right) + 1 = 3$$

Vi får alltså följande referensfilter:



Tabell ger (r=1): C₁ = C₃ = 1F och L₂ = 2H.

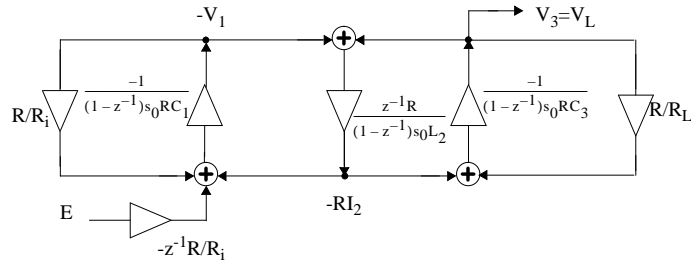
Tabell s. 100 ger signalfödesschema för ett elliptiskt filter, genom att sätta C₂ = 0 fås:



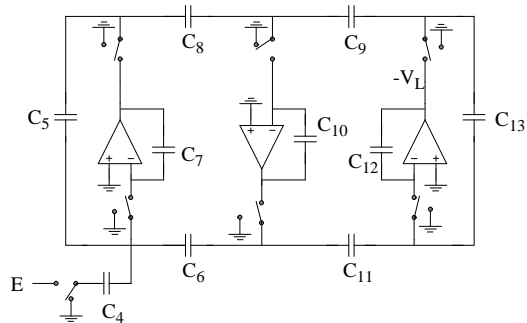
LDI-transformera och kompensera för $z^{-1/2}$ i yttre grenarna:

$$C_1' = C_3' = C_1 - \frac{1}{2s_0 R_i} = 0.92F$$

Detta ger följande flödesschema:



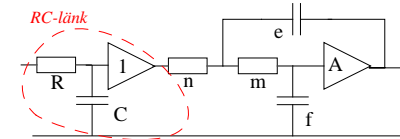
Detta ger följande realisering:



$$R = R_i = R_L = 1 \Rightarrow \frac{C_4}{C_7} = \frac{C_5}{C_7} = \frac{C_6}{C_7} = \frac{C_4}{C_7} = \frac{C_{13}}{C_{12}} = \frac{1}{s_0 C_1'} = 0.17$$

$$\frac{C_8}{C_{10}} = \frac{C_9}{C_{10}} = \frac{1}{s_0 L_2} = 0.0785$$

3. Filtret är ett LP-filer utan ändliga nollställen. Vi kan realisera den reella polen med en buffrad RC-länk och det komplexa polparet med 1 LP (UG) s. 74 i formelsamlingen.



Andragsradslänken:

$$UG: A = 1, m = n, e = \frac{1}{m\sigma_p} \text{ och } \frac{e}{f} = 4Q^2$$

$$\sigma_p = |\operatorname{Re}(p_{2,3})| = 10\pi \text{ rad/s och}$$

$$Q = \frac{\omega_{0p}}{2\sigma_p} = \frac{\sqrt{(\operatorname{Re}(p_{2,3}))^2 + (\operatorname{Im}(p_{2,3}))^2}}{2\sigma_p} = 1$$

$$\text{Välj t.ex. } m = n = 10k\Omega, e = \frac{1}{m\sigma_p} = \frac{1}{10k \cdot 10k\pi} = 3.2nF, f = \frac{e}{4Q^2} = 0.8nF$$

RC-länken:

$$\text{Välj t.ex. } R = 10k\Omega, C = \frac{1}{|p_1|R} = \frac{1}{2\pi \cdot 10k \cdot 10k} = 1.6nF$$

- 4.

- Enligt tabellen så är $\lambda_n = 0.01V^{-1}$ och $\lambda_p = 0.02V^{-1}$ då $L_{\min} = 10\mu m$.
- Fasmarginalen var given 60° . Enligt kokboksreceptet och kompenseringstabellen skall vi välja $X_\phi = 2.2$ och $X_z = 10$.
 $z_1 = X_z \cdot GB = g_{m6}/C_C$ och $p_2 = -g_{m6}/C_L > -X_\phi GB$
 Om dessa två ekvationer divideras med varandra så fås en undre gräns på C_C :

$$C_C = \frac{X_\phi}{X_z} C_L = 2.2pF$$
- Det finns ingen uppgift om insvängningstiden T_S så därför kan I_5 beräknas med hjälp av Slew rate: $I_5 = SR \cdot C_C$. I punkt 2 beräknades C_C :

$$I_5 = 8M \cdot 2.2p = 17.6\mu A$$
- Bestäm storleken på transistor M3 genom att använda CMR. Enligt receptet:

$$S_3 = S_4 = \frac{I_5}{K'_3 [V_{DD} - V_{in,hi} - |V_{T3}| + V_{T1}]^2} = \frac{17.6\mu}{8\mu(5-3-1+1)^2} \approx 0.55$$

$$S_{\min} = 1 \Rightarrow S_3 = S_4 = 1.$$

5. Se till att polen som uppstår på grund av M3 inte är dominant.

$$P_{M3} = \frac{-g_{m3}}{2 \cdot 0.67 \cdot C_{ox} L_{min} W_3} = \frac{\sqrt{2K'_p S_3 I_3}}{2 \cdot 0.67 \cdot C_{ox} L_{min} W_3} = \frac{\sqrt{8\mu \cdot 1 \cdot 17.6\mu}}{1.33 \cdot 0.43f \cdot 10\mu \cdot 10\mu} \approx 206 \text{Mrad/s}$$

vilket är större än $10GB=62.8\text{Mrad/s}$ och p_3 har därmed liten effekt på fasmarginalen.

6. Bestäm storleken på transistor M2 genom att använda GB.

$$S_1 = S_2 = \frac{g_{m2}^2}{K'_2 I_5} = \frac{(GB \cdot C_C)^2}{K'_2 I_5} = \frac{(2\pi \cdot 1M \cdot 2.2p)^2}{17\mu \cdot 17.6\mu} \approx 0.63 \text{ välj } S_1 = S_2 = 1$$

$$\text{Detta ger } g_{m2} = \sqrt{2K'_2 S_2 I_2} = 17.3\mu \text{ A/V}$$

7. Använd CMR för att beräkna storleken på transistor M5:

$$V_{DS, sat5} = V_{in, lo} - V_{SS} - \sqrt{I_5/\beta_1} - V_{T1} = -0.02 < 0.1. \text{ Kravet ej uppfyllt öka } S_1 = S_2$$

$$S_5 = \frac{2I_5}{K'_5 V_{DS, sat5}^2} = \frac{2 \cdot 17.6\mu}{17\mu (0.1)^2} = 207$$

8. Använd OR för att beräkna storleken på transistor M6:

$$S_6 = \frac{g_{m6}}{K'_6 (V_{DD} - V_{out, hi})} = \frac{X_\phi GBC_L}{K'_6 (V_{DD} - V_{out, hi})} = \frac{2.2 \cdot 1M \cdot 2\pi \cdot 10p}{8\mu \cdot (5 - 4)} \approx 17.3$$

9. Beräkna strömmen I_6 .

$$I_6 = \max \left[\frac{g_{m6}^2}{2K'_6 S_6}, \frac{S_6}{S_3} I_1 \right] = \max \left[\frac{(X_\phi \cdot GB \cdot C_L)^2}{2K'_6 S_6}, \frac{S_6}{S_3} \cdot \frac{I_5}{2} \right] = \max[65, 152] \mu\text{A}$$

$$\text{Dvs } I_6 = 152\mu\text{A} \Rightarrow g_{m6} = \sqrt{2K'_6 S_6 I_6} = 205\mu \text{ A/V}$$

10. Bestäm storleken på transistor M7, utnyttja $V_{GS5} = V_{GS7}$.

$$S_7 = S_5 \frac{I_7}{I_5} = S_5 \frac{I_6}{I_5} = 207 \frac{152}{17.6} \approx 1788$$

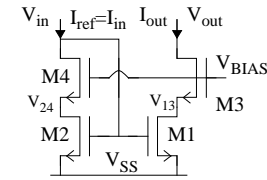
11. Kontrollera kraven på effekt och förstärkning:

$$P_{diss} = (V_{DD} - V_{SS})(I_5 + I_6) = 10 \cdot (152 + 17.6)\mu \approx 1.7 \text{mW}$$

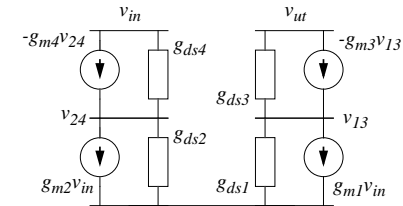
$$A_v = \frac{2g_{m1} \cdot g_{m6}}{I_5(\lambda_2 + \lambda_3)I_6(\lambda_6 + \lambda_7)} = \frac{2 \cdot 17.3\mu \cdot 205\mu}{17.6\mu \cdot 0.03 \cdot 152\mu \cdot 0.03} \approx 2946$$

12. Kravet på förstärkningen ej uppfyllt. Minska I_6 eller öka S_1

5.



a)



b)

$$r_{in} = \left. \frac{v_{in}}{i_{in}} \right|_{v_{ut} = 0}$$

Potentialen i v_{in} kan lösas med nodanalys.

$$v_{in}: \quad (v_{24} - v_{in})g_{ds4} + i_{in} + g_{m4}v_{24} = 0$$

$$v_{24}: \quad (0 - v_{24})g_{ds2} + (v_{in} - v_{24})g_{ds4} - g_{m4}v_{24} - g_{m2}v_{in} = 0$$

vilket ger

$$\begin{bmatrix} -g_{ds4} & g_{ds4} + g_{m4} \\ (g_{ds4} - g_{m2}) & (-g_{ds2} - g_{ds4} - g_{m4}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{in} \\ v_{24} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -i_{in} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$v_{in} = i_{in} \frac{g_{ds2} + g_{ds4} + g_{m4}}{(g_{ds2} + g_{ds4} + g_{m4})g_{ds4} - (g_{ds4} + g_{m4})(g_{ds4} + g_{m2})}$$

$$r_{in} = \left. \frac{v_{in}}{i_{in}} \right|_{v_{ut} = 0} = \frac{g_{ds2} + g_{ds4} + g_{m4}}{(g_{ds2} + g_{ds4} + g_{m4})g_{ds4} - (g_{ds4} + g_{m4})(g_{ds4} + g_{m2})}$$

$$= \frac{g_{ds2} + g_{ds4} + g_{m4}}{(g_{m2} + g_{ds2})g_{ds4} + g_{m4}g_{m2}} \approx \frac{1}{g_{m2}}$$

$$r_{ut} = \left. \frac{v_{ut}}{i_{ut}} \right|_{v_{in} = 0} = \frac{v_{13} + \frac{(i_{ut} + g_{m3}v_{13})}{g_{ds3}}}{i_{ut}} = \frac{i_{ut} + \frac{(1 + g_{m3}/g_{ds1})i_{ut}}{g_{ds3}}}{i_{ut}} =$$

$$= \frac{g_{ds1} + g_{ds3} + g_{m3}}{g_{ds1} \cdot g_{ds3}} \approx \frac{g_{m3}}{g_{ds1} \cdot g_{ds3}}$$

$$g_{m1} = g_{m2} = \sqrt{2\beta_1 I_1} = \sqrt{5 \cdot 2 \cdot 17\mu \cdot 20\mu} = 58\mu \text{ A/V}$$

$$g_{m3} = g_{m4} = \sqrt{2\beta_3 I_3} = \sqrt{20 \cdot 2 \cdot 17\mu \cdot 20\mu} = 116\mu \text{ A/V}$$

$$g_{ds1} = g_{ds2} = \lambda I_1 = 0.01 \cdot 20\mu = 0.2\mu\Omega^{-1}$$

$$g_{ds3} = g_{ds4} = \lambda I_1 = 0.01 \cdot 20\mu = 0.2\mu\Omega^{-1}$$

Vi får då $r_{ut} = 29\text{M}\Omega$ och $r_{in} = 17\text{k}\Omega$

c) $V_{out,MIN}$ är given av den minsta möjliga spänning då transistorerna är mättad.

$$\text{Låt } \Delta V_i = V_{DSi, sat} = V_{GSi} - V_T$$

$$\text{Då } I_{in} = I_{ref} \text{ gäller } V_{GS1} = V_{GS2} = \sqrt{\frac{2I_{ref}}{\beta_2}} + V_T = \sqrt{\frac{2 \cdot 20\mu}{17\mu \cdot 5}} + V_T = 1.68 \text{ V och}$$

$$V_{GS3} = V_{GS4} = \sqrt{\frac{2I_D}{\beta_2}} + V_T = \sqrt{\frac{2 \cdot 20\mu}{17\mu \cdot 20}} + V_T = 1.34 \text{ V.}$$

Detta ger $V_{DS1} = V_{13} = V_{BIAS} - V_{GS3} = 2.5 - 1.34 = 1.16 > \Delta V_1 = 0.68 \text{ V}$. M1 är således mättad (detta var givet i uppgiften). För att även M3 ska vara mättad ska gälla:

$$V_{DS3} = V_{out} - V_{13} = V_{out} - 1.16 > \Delta V_3 = 0.34, \text{ dvs. } V_{out} > 1.5 \text{ V.}$$

d) $V_{out,MIN}$ kan miskas genom att sänka V_{BIAS} . Detta påverkar inte småsignal parametrarna och således inte in- och ut-resistanserna. Man får dock inte sänka V_{BIAS} så mycket att M1 och M2 hamnar i det linjära området. Man kan också sänka ΔV_i genom att öka S_i . Detta ger större g_{mi} och därmed lägre inresistans och högre utresistans.

e)

Betrakta transistor M2 och M4. För att M2 skall vara mättad så måste $V_{in} > V_T$ och $V_{24} > V_{in} - V_T$. För M4 måste gälla att $V_{BIAS} - V_{24} > V_T$ och dessutom $V_{in} - V_{24} > V_{BIAS} - V_{24} - V_T$ dvs att $V_{in} > V_{BIAS} - V_T$.

Sammanfattningsvis:

$$\left(\begin{array}{l} V_{in} > V_T \\ V_{24} < V_{BIAS} - V_T \\ V_{24} > V_{in} - V_T \\ V_{in} > V_{BIAS} - V_T \end{array} \right.$$

$$\text{Men } I_2 = I_4 \Rightarrow \beta_2(V_{in} - V_T)^2 = \beta_4(V_{BIAS} - V_{24} - V_T)^2 \Rightarrow$$

$$V_{24} = -\sqrt{\frac{\beta_2}{\beta_4}}(V_{in} - V_T) + V_{BIAS} - V_T$$

Vi får då villkoren:

$$\left(\begin{array}{l} V_{in} > V_T = 1 \\ -\sqrt{\frac{\beta_2}{\beta_4}}(V_{in} - V_T) + V_{BIAS} - V_T < V_{BIAS} - V_T \Rightarrow V_{in} > V_T = 1 \\ -\sqrt{\frac{\beta_2}{\beta_4}}(V_{in} - V_T) + V_{BIAS} - V_T > V_{in} - V_T \Rightarrow V_{in} < \frac{V_{BIAS} + \sqrt{\frac{\beta_2}{\beta_4}}V_T}{\sqrt{\frac{\beta_2}{\beta_4}} + 1} = 2 \\ V_{in} > V_{BIAS} - V_T = 1.5 \end{array} \right.$$

Vi får alltså: $1.5 < V_{in} < 2$

6.

a) Track-and-Hold med förstärkande buffert.

För att skissera kurvan så måste buffertens förstärkning beräknas.

$$v_{ut} = -\frac{g_{m2}v_{in'}}{g_{ds1} + g_{m1} + g_{ds2}} \approx -\frac{g_{m2}}{g_{m1}}v_{in}' \text{ dvs förstärkningen är } A = \frac{v_{ut}}{v_{in}'} \approx -\frac{g_{m2}}{g_{m1}}$$

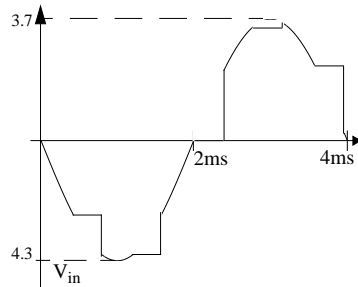
Antag att båda transistorerna är mättade. Detta ger att

$$A \approx -\frac{\sqrt{2K_N|I_D|S_2}}{\sqrt{2K_P|I_D|S_1}} = \sqrt{\frac{K_N'S_2}{K_P'S_1}} \approx -\sqrt{\frac{17 \cdot 13}{8 \cdot 3}} \approx -3$$

I arbetspunkten gäller :

$$I_2 = \frac{\beta_2}{2}(V_{GS2} - V_T)^2 = \frac{17\mu \cdot 13}{2} \cdot (2 - 1)^2 = 0.11 \text{ mA och}$$

$$V_{SG1} = \sqrt{\frac{2I_1}{\beta_1}} + V_T = \sqrt{\frac{2 \cdot 0.11 \text{ m}}{8\mu \cdot 3}} + 1 = 4 \text{ V. Dvs } V_{UT} = 4 \text{ V i arbetspunkten.}$$



b) Dummy-transistorn används för att delvis kompensera för clock-feedthrough. Transistorn skall väljas hälften så stor som M3. Detta medför att laddningen från C_{DG4} och C_{GS4} kompenserar laddningen från C_{GD3} när klocksignalen slår om.

c) M3 arbetar antingen i sitt linjära område eller är avstängd ($R_{ON} = \infty\Omega$).

d) Första polen bestäms av R_{ON} för switchen och C_L . Den andra polen av $r_{ut} = \frac{1}{g_{m1}}$ för förstärkaren och C_{out} . Switchens resistans ges av r_{DS} (linjära området) dvs

$$R_{ON} = \frac{1}{K_N'S_3(V_\phi - V_{T3})} = \frac{1}{25\mu \cdot 2 \cdot 7} = 2.9 \text{ k}\Omega.$$

$$\text{För M1 blir } g_m = \sqrt{2\beta_1 I_1} = \sqrt{2 \cdot 17\mu \cdot 0.11 \text{ m}} = 61 \mu \text{ A/V}$$

Därmed blir polerna

$$p_1 = -\frac{1}{R_{ON}C_L} = -16.4 \text{ M rad/s och } \frac{g_m}{C_{ut}} = -61 \text{ M rad/s}$$